

Ptfe硅晶圆花篮/支架，用于酸蚀刻和清洗工艺，2 4 6 8英寸可定制，耐高温

货号: PL-CP158



简介

高纯度PTFE硅晶圆载具，专为极端酸蚀刻和清洗工艺设计。针对2至8英寸晶圆进行了优化，这些坚固的可定制载具确保在最苛刻的半导体制造环境中实现无污染处理和热稳定性，适用于B2B采购。

[了解更多](#)

应用	描述	核心优势
半导体蚀刻	在浓 HF 或 BOE (缓冲氧化物蚀刻) 溶液中处理晶圆以去除介电层。	对强酸的卓越抵抗力确保了载具的长期耐用性。
RCA 清洗工艺	在高温下利用 SC-1 和 SC-2 溶液去除有机和金属污染物。	高热稳定性可防止在高温氧化浴中发生变形。
光伏电池生产	在高效太阳能电池制造过程中对硅晶圆进行制绒和清洗。	坚固的设计以一致的可靠性应对大批量的工业产量。
MEMS 制造	在复杂的深反离子蚀刻和湿法释放工艺中牢固地固定基底。	精密加工的槽位保护脆弱的微机械结构免受接触损坏。
皮拉尼 (Piranha) 蚀刻清洗	在硫酸和过氧化氢的混合物中处理晶圆以去除重有机物。	材料不受强氧化侵蚀，防止设备降解。
纳米技术研究	在实验性化学气相沉积或液相处理中专门处理定制基底。	完全定制允许非标准晶圆尺寸和独特的几何形状支持。
光电子组装	在外延生长或薄膜沉积之前清洗蓝宝石或砷化镓晶圆。	PTFE 材料的纯度消除了光学器件中痕量金属干扰的风险。

规格类别	PL-CP158 参数详情	可用性/选项
型号系列	PL-CP158 硅晶圆载具	标准和定制设计
主要材料	高纯度 PTFE (聚四氟乙烯)	可根据要求提供 PFA 选项
兼容晶圆尺寸	2 英寸、4 英寸、6 英寸、8 英寸	可完全定制任何直径
槽位配置	容量和间距根据项目定义	根据用户规格定制
温度范围	工作温度范围从深冷到 260°C	取决于工艺的定制
化学抗性	全系列酸、碱和溶剂	通用的化学兼容性
制造方法	5 轴 CNC 精密加工	提供定制几何形状
排水特性	可定制的底部/侧面排水口	针对特定溶液流速进行优化
把手设计	可拆卸或集成的手动/机器人把手	为工具兼容性定制
纯度等级	痕量分析和半导体级	认证的高纯度材料